

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭63-239676

⑫ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)10月5日

G 11 C 11/34

3 6 2

G-8522-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全14頁)

⑭ 発明の名称 半導体記憶装置

⑮ 特 願 昭62-71428

⑯ 出 願 昭62(1987)3月27日

⑰ 発 明 者 山 口 孝 紀 東京都青葉区今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内

⑱ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑲ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

要 約

1. 発明の名称

半導体記憶装置

2. 特許請求の範囲

1. ノーマリアレイを構成する複数のデータ線と、これらデータ線に平行に出力される複数の読み出しデータを受け外部から供給されるクロック信号に従ってシリアルに出力する直列変換回路と、上記直列変換回路のシリアル出力動作を制御するタイミング制御回路を含む、上記シリアル出力動作を開始するタイミングが外部から供給される起動制御信号によって起動されてから上記シリアル出力動作を開始するまでの上記クロック信号のタイタル数を指定することによって任意に設定しうるものであることを特徴とする半導体記憶装置。

2. 上記タイミング制御回路は、上記起動制御信号に同期して外部から供給される上記タイタル数を取り込み上記クロック信号に従ってカウントダウンするカウンタ回路と、上記カウンタ回路の出力信号が全ビット論理"0"になることを検出し

シリアル出力動作を行うための内部クロック信号を形成するタイミング発生回路を含むものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体記憶装置。

3. 上記半導体記憶装置はデュアル・ポート・ノーマリであり、上記タイタル数はランダム・アクセス・ポート用の複数のデータ入力端子を介して供給されるものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項記載の半導体記憶装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体記憶装置に関するもので、例えば、ランダム入出力機能とシリアル入出力機能を有する半導体記憶装置のデュアル・ポート・ノーマリを利用して特に有効な技術に関するものである。

(従来の技術)

文字あるいは図形等をCRT(陰極線管)の画面上に表示させるための画像用フレームバッファメモリについては、例えば日通マシログルヒル社発

行の1986年3月24日付「日経エレクトロニクス」の343頁〜364頁に記載されている。

上記に記載されるデュアル・ポート・メモリには、記憶データを1ビット又は数ビット単位で入出力するためのランダム・アクセス・ポートと、記憶データをメモリアレイのワード単位でシリアルに入出力するためのシリアル・アクセス・ポートが設けられる。

(論議が解決しようとする問題点)

このようなデュアル・ポート・メモリには、第4図に示すように、外部から供給される制御信号として、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} 、カラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} 及びライトイネーブル信号 \overline{WE} のほかに、例えばデータ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ 、シリアル出力制御信号 \overline{SOC} 及びシリアルクロック信号 \overline{SC} が設けられる。デュアル・ポート・メモリにおいて読み出しデータのシリアル出力動作が行われる読み出しデータ駆逐モードは、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} がハイレベルからロウレベルに変化された時点で、

カラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} が入り及びライトイネーブル信号 \overline{WE} がハイレベルであり、データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ がロウレベルであることによって識別される。このとき、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりに同期して読み出しを行うワード線のアドレス A_X が外部端子 $A_0 \sim A_1$ に供給され、選択されたワード線に結合されるメモリスルからの読み出し信号が対応するデータ線に駆立される。また、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} にやや遅れてロウレベルとされるカラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} の立ち下がりに同期してシリアル出力する先頭カラムアドレス A_Y が外部端子 $A_0 \sim A_1$ に供給される。その後データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ がハイレベルに戻されることによって、各データ線にパラレルに出力された読み出しデータをシリアル・アクセス・ポートのデータレジスタに搬送するためのタイミング信号 ϕ が形成されるとともに、シリアルクロック信号 \overline{SC} に同期して形成されるタイミング信号 ϕ に従ってデータレジスタに搬送され

た新しいシリアルデータ（ $A_X \cdot A_Y$ ）以降のデータ）の出力動作が開始される。

データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ を一旦ロウレベルとした後、ハイレベルに戻してシリアル出力動作を開始させるタイミングは、このデュアル・ポート・メモリを駆動する外部のメモリ制御回路に設けられ水平同期位置を計数するためのカウンタ回路の出力信号をモジュラすることによって制御される。すなわち、デュアル・ポート・メモリの1ワード線に結合されるメモリスルの読み出しデータの出力が終わりに近づく時点でデュアル・ポート・メモリの再起動が行われ、新しいワード線のメモリスルの読み出しデータが対応するデータ線に出力される。その後、メモリ制御回路のカウント回路の計数値が再度選択されたワード線に結合されるメモリスルからの読み出しデータのシリアル出力動作の末尾を示す値となり、シリアルクロック信号 \overline{SC} がロウレベルとなる時間を見計らって、データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ がハイレベルに戻され、新しく選択されたワード線に結合

されるメモリスルからの読み出しデータがデータレジスタに搬送され、シリアル出力動作が開始される。これにより、CRTのドットレートに同期したリアルタイムなデータ駆逐が行われる。

しかしながら、ディスプレイ技術が進展し、高解像度のCRTが開発されることによって、表示データがシリアル出力されるドットレートが高速化してきたため、データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ をシリアルクロック信号 \overline{SC} に同期して立ち上げることが困難となってきた。すなわち、データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ をハイレベルに戻すタイミングは、前述のように、メモリ制御回路のカウント回路の出力信号をモジュラすることによって決定される。したがって、シリアルクロック信号 \overline{SC} によってカウンタ回路が歩進する経過時間とその出力信号をデコードしてモジュラする経過時間が、シリアルクロック信号 \overline{SC} の周期に比較して相対的に大きくなると、データ駆逐制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ をシリアルクロック信号 \overline{SC} に同期して立ち上げることが困難となるものである。このため、第4図に

点域で示すように、データ伝送制御信号 $\overline{DT}/\overline{OE}$ とシリアルクロック信号 SC との時間関係が重要であり、特にデータ伝送制御信号 $\overline{DT}/\overline{OE}$ の立ち上がりがシリアルクロック信号 SC の立ち上がりより遅れることによって、新しく選択されたワード域に結合されるメモリセルからの読み出しデータをデータレジスタに伝送するためのタイミング信号 ϕ が遅くなる。これにより、シリアルデータ伝送動作が不安定なものとなり、表示画像が乱れてしまう結果となる。

この発明の目的は、シリアルデータ伝送動作の安定化を図ったデュアル・ポート・メモリ等の半導体記憶装置を提供することにある。

この発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、この明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

(問題点を解決するための手段)

本願において開示される実施例のうち代表的なものの特徴を簡単に図示すれば、下記の通りである。すなわち、デュアル・ポート・メモリのデー

タ伝送時において、読み出しデータのデータレジスタへの伝送動作を開始するタイミングをデータ伝送タイトル駆動後伝送動作を開始するまでの間のクロック信号のタイトル数を指定することによって任意に設定できるようにするものである。

(作 用)

上記手段によれば、デュアル・ポート・メモリのデータ伝送動作を開始する時点においてメモリ制御回路のカウント回路の計数値に従って伝送動作を開始するクロック信号位置を任意に指定することができ、またデュアル・ポート・メモリ内に設けられるカウントダウン用のカウンタ回路によりクロック信号に同期した伝送動作を行うことができるため、読み出しデータの伝送動作の安定化を図ったデュアル・ポート・メモリ等の半導体記憶装置を実現できるものである。

(実施例)

第1図には、この発明が適用されたデュアル・ポート・メモリの一実施例のブロック図が示されている。同図の各部ブロックは、公知の半導体

装置の製造技術によって、特に制限されないが、単結晶シリコンのような1個の半導体基板上において形成される。

この実施例のデュアル・ポート・メモリには、4ビット単位でアクセスされダイナミック型RAMを基本構成とするランダム・アクセス・ポートと、ワード単位で記憶データのシリアル入出力を行うシリアル・アクセス・ポートが設けられる。これにより、デュアル・ポート・メモリは、通常のシリアル入出力動作を行いながら同時にランダム・アクセス・ポートのアクセスを行うことが可能になっている。また、特に制限されないが、ランダム・アクセス・ポートに含まれるランダム入出力回路 IO にはラスタ読取等を行うための論理読取回路が設けられ、この論理読取回路を制御するための論理制御回路 LC が設けられる。論理読取回路には論理線や論理和等の各種の読取方法が用意され、どの読取を行うかは制御信号の特定の組み合わせにおいてアドレス信号用外部端子 $A_0 \sim A_3$ を介して入力される読取コードによって指

定される。

シリアル・アクセス・ポートには、シリアル入出力回路 SI/O が設けられ、通常4つのシリアル入出力端子 $SI_0 \sim SI_3$ を介して、4つのメモリアレイに対応する記憶データが同時にシリアルに入出力される。また、読取コードの特定の組み合わせにおいて、4つのメモリアレイから出力される読み出しデータをシリアル入出力端子 SI_0 を介して交互に出力するいわゆる $M \times 1$ ビット構成のメモリとして使用することもできる。

デュアル・ポート・メモリには、外部の装置から、通常のダイナミック型RAMで用いられるロウアドレスストロープ信号 \overline{RAS} 、コラムアドレスストロープ信号 \overline{CAS} 及びライトイネーブル信号 \overline{WE} 等の制御信号の他、出力制御及びランダム・アクセス・ポートとシリアル・アクセス・ポートとの間のデータ伝送制御に用いられるデータ伝送制御信号 $\overline{DT}/\overline{OE}$ と、シリアル・アクセス・ポートの入出力切り換え制御に用いられるシリアル出力制御信号 \overline{SOE} 及びシリアル入出力時にお

いて同周信号として用いられるシリアルクロック信号SCが入力される。

この実施例のデュアル・ポート・メモリのランダム・アクセス・ポートには、特に制限されないが、4つのメモリアレイM-ARY1~M-ARY4が設けられ、それぞれのメモリアレイに対応してセンスアンプSA1~SA4、カラムスイッチCSW1~CSW4が設けられる。また、メモリアレイM-ARY1~M-ARY4に共通に、ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードRCD及びロウアドレスデコードRDが設けられる。これらのアドレスデコードは、半導体基板上のメモリアレイの配置に応じて、任意に設けられることもある。第2図には、メモリアレイM-ARY1とその周辺回路が模式的に示されている。

第2図において、メモリアレイM-ARY1は、同図の垂直方向に配置される $m+1$ 本のワード線と、同図の水平方向に配置される $n+1$ 本の格納データ線及びこれらのワード線と格納データ線の

交点に配置される $(m+1) \times (n+1)$ 個のメモリアルセルにより構成される。

メモリアレイM-ARY1を構成するダイナミック型メモリアルセルは、情報記憶用キャパシタとアドレス選択用MOSFETにより構成される。同一の行に配置される $m+1$ 個のメモリアルセルのアドレス選択用MOSFETのゲートは、対応するワード線に結合される。各ワード線は、さらにロウアドレスデコードRDに結合され、Xアドレス信号AX0~AX1に指定される一本のワード線が選択・指定される。

ロウアドレスデコードRDは、ロウアドレスバッファRADBから供給される格納内部アドレス信号 $\bar{L}=0 \sim \bar{L}=1$ （ここで、例えば外部から供給されるXアドレス信号AX0と同様の内部アドレス信号 $\bar{L}=0$ と逆相の内部アドレス信号 $\bar{L}=1$ をそれぞれ格納内部アドレス信号 $\bar{L}=0$ のように表す。以下同じ）をデコードし、Xアドレス信号AX0~AX1に指定される一本のワード線を選択し、ハイレベルの選択状態とする。ロウアドレ

スデコードRDによるワード線の選択動作は、タイミング制御回路TCから供給されるワード線選択タイミング信号 ϕ_{sel} に従って行われる。

ロウアドレスバッファRADBは、アドレスマルチプレクサAMXから供給されるロウアドレス信号を受け、格納内部アドレス信号 $\bar{L}=0 \sim \bar{L}=1$ を形成して、ロウアドレスデコードRDに供給する。この実施例のダイナミック型RAMでは、ロウアドレスを指定するためのXアドレス信号AX0~AX1とカラムアドレスを指定するためのYアドレス信号AY0~AY1は、同一の外部端子A0~A1を介して区別されて供給されるいわゆるアドレスマルチプレクス方式を採用している。したがって、外部から制御信号として供給されるロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに同期してXアドレス信号AX0~AX1が、またカラムアドレスストローブ信号CASの立ち下がりに同期してYアドレス信号AY0~AY1がそれぞれ外部端子A0~A1に供給される。さらに、この実施例のダイナミック型RAMには、メモリアルセルの記憶データを所定の周期内に読み出し、書き込みするための自動リフレッシュモードが設けられ、この自動リフレッシュモードにおいてリフレッシュすべきワード線を指定するためのリフレッシュアドレスカウンタRBCが設けられる。

アドレスマルチプレクサAMXは、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号 ϕ_{ref} に従って、外部端子A0~A1を介して供給されるXアドレス信号AX0~AX1とリフレッシュアドレスカウンタRBCから供給されるリフレッシュアドレス信号 $\bar{L}=0 \sim \bar{L}=1$ を選択し、ロウアドレス信号としてロウアドレスバッファRADBに伝達する。すなわち、タイミング信号 ϕ_{ref} がロウレベルとされる通常のメモリアクセスモードにおいて、外部端子A0~A1を介して外部の装置から供給されるXアドレス信号AX0~AX1を選択し、タイミング信号 ϕ_{ref} がハイレベルとされる自動リフレッシュモードにおいて、リフレッシュアドレスカウンタRBCから出力

されるリフレッシュアドレス信号 $\phi = 0 \sim c = 1$ を選択する。

前述のように、Xアドレス信号AX0~AX1はロウアドレスストローブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりに同期して外部端子A0~A1に供給されるため、ロウアドレスバッファRADBによるロウアドレス信号の取り込みは、タイミング制御回路TCにおいてロウアドレスストローブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりを検出して形成されるタイミング信号 $\phi_{\overline{RAS}}$ に従って行われる。

一方、メモリアレイM-ARY1の同一の列に配置されるメモリのアドレス選択用MOSFETのドレインは、対応する相補データ線に結合される。メモリアレイM-ARY1の各相補データ線は、その一方において、カラムスイッチCSW1の対応するスイッチMOSFETに結合され、さらに選択的に相補共通データ線 $\overline{CD1}$ （ここで、相補共通データ線の非反転信号線CD1及び反転信号線 $\overline{CD1}$ をあわせて相補共通データ線 $\overline{CD0}$ のように表す、以下同じ）に接続される。

カラムスイッチCSW1は、それぞれ対応する相補データ線に結合される $a+1$ 対のスイッチMOSFETによって構成される。これらのスイッチMOSFETの他方の端子は、相補共通データ線を構成する非反転信号線CD1又は反転信号線 $\overline{CD1}$ に共通に結合される。これにより、カラムスイッチCSW1は $a+1$ 組の相補データと共通相補データ線 $\overline{CD1}$ とを選択的に接続させる。カラムスイッチCSW1を構成する各対の二つのスイッチMOSFETのゲートはそれぞれ共通接続され、ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードRCDによって形成されるデータ線選択信号がそれぞれ供給される。

ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードRCDは、カラムアドレスバッファCADBから供給される相補内部アドレス信号 $\overline{A70} \sim \overline{A71}$ をデコードし、タイミング制御回路TCから供給されるデータ線選択タイミング信号 $\phi_{\overline{RAS}}$ に従って、上記データ線選択信号を形成し、カラムスイッチCSW1~CSW4に供給する。

カラムアドレスバッファCADBは、タイミング制御回路TCにおいてカラムアドレスストローブ信号 \overline{CAS} の立ち下がりを検出して形成される対応する信号 $\phi_{\overline{CAS}}$ に従って、外部端子A0~A1を介して供給されるYアドレス信号AY0~AY1を入力し、選択するとともに、相補内部アドレス信号 $\overline{A70} \sim \overline{A71}$ を形成してランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードRCDに供給する。

メモリアレイM-ARY1の各相補データ線は、その他方において、センスアンプSA1の対応する感位回路に結合され、さらにシリアル・アクセス・ポートのデータレジスタDR1の対応する感位回路に結合される。

センスアンプSA1の各感位回路は、交差接続される二つのCMOSインバータ回路からなるラッチをその基本構成とする。これらのセンスアンプ感位回路は、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号 $\phi_{\overline{RAS}}$ によって動作状態とされ、各メモリセルから対応する相補データ線に出

力される微小読み出し信号を増幅し、ハイレベル/ロウレベルの2値信号とする。

Yアドレス信号AY0~AY1に指定される相補データ線が選択的に接続される相補共通データ線 $\overline{CD1}$ は、ランダム・アクセス・ポート用入出力回路RIOに結合される。このランダム・アクセス・ポート用入出力回路RIOには、メモリアレイM-ARY2~M-ARY4に対応して設けられる相補共通データ線 $\overline{CD2} \sim \overline{CD4}$ が同様に関合される。

ランダム入出力回路RIOは、デュアル・ポート・メモリのランダム・アクセス・ポート書き込み動作モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号 $\phi_{\overline{RAS}}$ によって動作状態とされ、入出力端子IO1~IO4を介して外部の装置から供給される書き込みデータを相補書き込み信号とし、相補共通データ線 $\overline{CD1} \sim \overline{CD4}$ に伝送する。また、デュアル・ポート・メモリのランダム・アクセス・ポート読み出し動作モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給

されるタイミグ信号 ϕ_{T1} によって動作位置とされ、相補共通データ線 $D1 \sim D4$ を介して伝送されるメモリアレイの読み出し信号をともに増幅し、入出力端子 $101 \sim 104$ から送出する。さらに、このランダム入出力回路 $R10$ には、特に制限されないが、リード・モディファイ・ライト回路を用いて、メモリアレイから読み出したデータと入力データとの間で種々の演算を行い再演算を目的とする演算回路が設けられる。この演算回路には、ラスタ演算等の処理を行うための各種の演算モードが用意される。

演算回路の演算モードは、制御制御回路 FC によって決定される。制御制御回路 FC は、外部端子 $A0 \sim A3$ を介して供給される演算コードを保持するためのレジスタと、その演算コードをデコードし演算回路の演算モードを選択・決定するためのデコードを含む。演算コードは、カラムアドレスストローブ信号 CAS がロウアドレスストローブ信号 RAS に先立ってロウレベルとされ、同時にライトイネーブル信号 WE がロウレ

ベルとされる読み合わせにおいて、外部端子 $A0 \sim A3$ を介してデュアル・ポート・メモリに供給される。また、演算コードの特定の読み合わせは、伝送するシリアル入出力回路 $S10$ の出力をいわゆる $\times 1$ ビット構成とするための内部制御信号 ϕ として用いられる。

データ入出力用外部端子 $101 \sim 104$ には、伝送するように、デュアル・ポート・メモリのシリアル読み出し動作モードにおいて、逐次シリアル出力動作を開始するまでの間のシリアルクロック信号 SC のタイトル位が入力される。これにより、この実施例のデュアル・ポート・メモリは、逐次シリアル出力動作を開始するタイミグを任意に設定することができ、高速データレートに対応して短い周期とされるシリアルクロック信号 SC に安定して同期化されたシリアル出力動作を行うことができる。データ入出力用外部端子 $101 \sim 104$ に入力されるタイトル位は、内部信号 $101 \sim 104$ として、タイミグ制御回路 TC に送られる。

一方、この実施例のデュアル・ポート・メモリのシリアル・アクセス・ポートは、各メモリアレイの相補データ線に対応して設けられる $n+1$ ビットのデータレジスタ $DR1 \sim DR4$ と、データセレクト $DSL1 \sim DSL4$ 及びこれらのうちのデータレジスタとデータセレクトと共通に設けられるポイント PNT 、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード SCD 及びシリアル入出力回路 $S10$ によって構成される。なお、ポイント PNT 及びシリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード SCD は、半導体基板上におけるメモリアレイの配線の関係で位置決められることもある。

データレジスタ $DR1$ は、メモリアレイ $M-A1$ の各相補データ線に対応して設けられるデータラッチ用の $n+1$ 個のフリップフロップを含む。これらのフリップフロップの入出力ノードと対応する相補データ線のデータ信号線及び反転信号線の間には、データ駆動用のスイッチ $MOSFET$ がそれぞれ設けられ、そのゲートにはタイミ

グ制御回路 TC からデータ駆動用のタイミグ信号 ϕ_{T1} が供給される。

データレジスタ $DR1$ の各ビットは、さらにデータセレクト $DSL1$ の対応するスイッチ $MOSFET$ に結合される。データセレクト $DSL1$ は、上述のカラムスイッチ $CSW1$ と同様な構成とされ、データレジスタ $DR1$ の各ビットとシリアル入出力用相補共通データ線 $D31$ を選択的に接続する。データセレクト $DSL1$ の各対のスイッチ $MOSFET$ のゲートはそれぞれ共通接続され、ポイント PNT からレジスタ選択信号が供給される。

ポイント PNT は、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード SCD によって決定されるシリアル動作開始ビットを保持するラッチ回路（ポイントラッチ）と、 $n+1$ ビットのシフトレジスタ及びこれらの間に設けられる N チャンネル $MOSFET$ からなるスイッチ回路とにより構成される。シフトレジスタの最終ビットの出力端子 30 はその先頭ビットの入力端子に結合され

る。また、これらのスイッチMOSFETのゲートには、上記タイミング信号φ₁が共通に供給される。ポインタPNTのシフトレジスタは、デューアル・ポート・メモリのシリアル入出力モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給されるシフトクロック用タイミング信号φ₂に従って、ループ状のシフト動作を行う。ポインタラッチ回路に保持された選択信号は、タイミング信号φ₁がハイレベルとされることによって、シフトレジスタの初級値として供給される。

シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDは、カラムアドレスバッファCA DRから供給される相補内部アドレス信号A₀〜A₇をデコードし、Yアドレス信号AY₀〜AY₁で指定されるシリアル入出力の先頭ビットに対応するポインタPNTのビットのみを論理“1”とする。すなわち、シリアル入出力モードにおいては、Xアドレス信号AX₀〜AX₁によってワード線が選択され、Yアドレス信号AY₀〜AY₁によってシリアル入出力するべき先頭の

ラムアドレスが指定される。シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDによってポインタPNTの指定されたビットに書き込まれた論理“1”の信号は、タイミング信号φ₂に従ってポインタPNT内をループ状にシフトされる。この論理“1”の信号がシフトされることによって、データセレクトDSELには順次ハイレベルのレジスタ選択信号が供給され、データレジスタDR1の各ビットが次々にシリアル入出力用相補共通データ線DS1に送られる。これにより、この実施例のデューアル・ポート・メモリの記憶データのシリアル入出力を任意のカラムアドレスから開始することができ、例えば記憶メモリにおけるスクロール処理等を高度化することができる。

以上のことから、デューアル・ポート・メモリのシリアル読み出し動作モードにおいて、メモリレイム-ARY1のn+1番の相補データ線から出力されるn+1ビットの読み出しデータは、タイミングφ₁がハイレベルとされることによって

データレジスタDR1に取り込まれる。同時にポインタPNTでは、タイミング信号φ₁のハイレベルによってポインタラッチに保持される選択信号がシフトレジスタに初級値として記憶される。読み出しデータは、ポインタPNTから次々に送られるレジスタ選択信号に従って、シリアル入出力用相補共通データ線DS1を介してシリアル入出力回路SIOに送られる。一方、デューアル・ポート・メモリのシリアル書き込み動作モードにおいて、シリアル入出力端子SIO1からシリアル入出力回路SIOを介してシリアルに入力される書き込みデータは、ポインタPNTから次々に送られるレジスタ選択信号に従って、データレジスタDR1の対応するビットに順次入力される。データレジスタDR1に保持された書き込みデータは、タイミングφ₁がハイレベルとされることによって、メモリレイム-ARY1の選択されたワード線に結合されるn+1番のメモリセルに一言に書き込まれる。

シリアル入出力回路SIOは、シリアル入出力

用相補共通データ線DS1〜DS4及びシリアル入出力端子SIO1〜SIO4に対応して設けられる4つのメインアンプとデータ入力バッファ及びデータ出力バッファを含む。シリアル入出力回路SIOのデータ出力バッファは、デューアル・ポート・メモリの読み出しデータ搬送モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号φ₂のハイレベルによって動作状態とされ、対応するシリアル入出力用相補共通データ線DS1〜DS4を介して出力され対応するメインアンプによって増幅される読み出しデータを、シリアル入出力端子SIO1〜SIO4から外部の装置に出力する。また、シリアル入出力回路SIOのデータ入力バッファは、デューアル・ポート・メモリのシリアル書き込み動作モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号φ₂のハイレベルによって動作状態とされ、対応するシリアル入出力端子SIO1〜SIO4を介して外部の装置から供給される書き込みデータを相補書き込み信号とし、対応す

るシリアル入出力用相補共通データ線D31〜D34に伝送する。シリアル入出力回路310の記憶データにおけるシリアル入出力動作は、タイミング制御回路TCにおいて外部から供給されるシリアルクロック信号SCをもとに形成されるタイミング信号φに従って行われる。

この実施例のデュアル・ポート・メモリでは、通常シリアル入出力回路310のシリアル出力信号は、上記のように4つのシリアル入出力端子S101〜S104を介して4ビット同時に出力される。しかし、さらに記憶容量の大きなシリアルメモリを実現したい場合、このデュアル・ポート・メモリを、4つのメモリアレイM-ARY1〜M-ARY4から出力される読み出しデータを一つのシリアル入出力端子を介してシリアルに出力するいわゆる×1ビット構成のメモリとして用いることができる。この場合、前述のように、ランダム入出力回路R10の論理演算回路の演算コードを制御するための演算コードの読み合わせの一つが、シリアル出力を×1ビット構成とするため

の内部制御信号φとされる。シリアル入出力回路310は、記憶制御回路FCから供給される内部制御信号φがハイレベルになると、4線のシリアル入出力用相補共通データ線D31〜D34を介してそれぞれシリアルに出力される読み出しデータを、シリアル入出力回路310内に設けられるマルチプレクサによって順次選択し、一つのシリアル入出力端子S101を介して外部の装置に出力する。このシリアル出力は、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号φに従って行われるため、4つのシリアル入出力端子S101〜S104によって同時に4ビットのシリアル出力が行われる場合の各入出力端子のデータレートと同じデータレートとなる。

タイミング制御回路TCは、外部から制御信号として供給されるロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} 、カラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} 、ライトイネーブル信号 \overline{WE} 、データ記憶制御信号 $\overline{DT/DE}$ 及びシリアル出力制御信号 \overline{SOE} によって、上記各線のタイミング信号を形成し、各回路

に供給する。また、外部から供給されるシリアルクロック信号SCにより、シリアル入出力動作を同期化するためのタイミング信号φを形成し、シリアル入出力回路310に供給する。

各制御信号が適宜な読み合わせとされることで、デュアル・ポート・メモリの動作モードが指定される。例えば、まずロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} がロウレベルとなり、続いてカラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} がロウレベルとなる時点でライトイネーブル信号 \overline{WE} がハイレベルであると、通常のランダム・アクセス・ポートの読み出し動作モードとされる。ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} がロウレベルとなり、続いてカラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} がロウレベルとなる時点でライトイネーブル信号 \overline{WE} がロウレベルである場合、通常のランダム・アクセス・ポートの書き込み動作モードあるいは読み書き込み動作モードとされる。さらに、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} の立ち下がり時点でライトイネーブル信号 \overline{WE} がハイレベルでありデータ記憶制御信号

$\overline{DT/DE}$ がロウレベルの場合、メモリアレイの読み出しデータをデータレジスタDR1〜DR4に搬送しいわゆるシリアル読み出しを行うための読み出しデータ搬送モードとされる。

前述のように、この実施例のデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ搬送モードでは、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} のロウレベルへの立ち下がりに同期して、データ入出力用外部端子101〜104に順次4次のシリアル読み出しデータのデータ搬送動作を開始するまでのシリアルクロック信号SCのサイクル数が指定される。このため、タイミング制御回路TCには、データ入出力端子101〜104を介して入力されるサイクル数を取り込み、シリアルクロック信号SCに従ってカウントダウンするためのカウンタ回路CTRが設けられる。各データ線に出力された読み出しデータは、タイミング制御回路TCのカウンタ回路CTRの計数値が0となることによって形成されるタイミング信号φ₀によってデータレジスタDR1〜DR4に搬送され、さらにタイ

キング信号 ϕ_k によってシリアル入出力回路310からシリアル入出力端子3101-3104を介して外部に出力される。

次に、タイミング制御回路TCは、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がり時点でデータ送受信制御信号DT/OSとともにライトイネーブル信号WEがロウレベルでありかつシリアル入出力制御信号SOEがハイレベルの場合は、デュアル・ポート・メモリをシリアル書き込み動作モードとし、シリアル入出力端子3101-3104を介して供給されるシリアル書き込みデータがデータレジスタDR1-DR4に入力される。また、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がり時点でデータ送受信制御信号DT/OSとともにライトイネーブル信号WEがロウレベルでありかつシリアル入出力制御信号SOEがロウレベルの場合は、書き込みデータ送モードとされ、送受信タイミング信号 ϕ_k が形成される。これにより、データレジスタDR1-DR4の送受信スイッチMOSFETがオン状態とされて、上記シ

リアル書き込み動作モードによってデータレジスタDR1-DR4にセットされた書き込みデータがメモリアレイの選択されたワードに結合される。0+1ビットのメモリアルに一語に入力される。デュアル・ポート・メモリのシリアル・アクセス・ポートを用いたシリアル書き込み動作は、上記のシリアル書き込み動作モードを実行した後、書き込みデータ送モードを組み合わせることで実行することによって、実現される。

一方、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに対応して、コラムアドレスストローブ信号CASがハイレベルからロウレベルに変化される場合、いわゆるCASビフアRASリフレッシュモードとされる。また、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がり時点でライトイネーブル信号WEがロウレベルであると、読取モード設定タイトルとされ、外部端子A0-A3を介して供給される読取コードが読取制御回路FC内のレジスタに取り込まれる。

上記読取モード設定タイトルを除く各動作モ

ードにおいては、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに同期して、ワード数を指定するためのXアドレス信号AX0-AX1が外部端子A0-A1に供給され、またコラムアドレスが必要な動作モードにおいては、コラムアドレスストローブ信号CASの立ち下がりに同期して、相補データ数を指定するためのYアドレス信号AY0-AY1が外部端子A0-A1に供給される。

第1図には、第2図のデュアル・ポート・メモリにおけるタイミング制御回路TCの一部の実施例の回路図が示されている。

前述のように、この実施例のデュアル・ポート・メモリでは、データ入出力用外部端子101-104を介して、ロウアドレスストローブ信号RASがロウレベルとなりデュアル・ポート・メモリが駆動されてから読み出しデータのデータ送受信動作が開始されるまでのシリアルクロック信号SCのタイクル数 n が過渡表示により指定される。これらのタイクル数は、内部データ101-104としてタイミング制御回路TCのカウント回路C

TRの対応するビットに供給される。

カウント回路CTRには、タイミング制御回路TC内に設けられる他のタイミング発生回路から、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに同期して形成されるタイミング信号 ϕ_{cs} が供給される。また、同図のタイミング制御回路TC内で形成される歩進用のタイミング信号 ϕ_{cp} が供給される。

カウント回路CTRの各ビットの反転出力信号C1-C5は、アンドゲート回路A01の4つの入力端子にそれぞれ入力される。アンドゲート回路A01の出力信号 ϕ_{1r} は、カウント回路CTRの反転出力信号C1-C5がすべて論理“0”すなわちカウント回路CTRの計数値が“0”であるときハイレベルとされる。

アンドゲート回路A01の出力信号 ϕ_{1r} はナンドゲート回路NA01の一方の入力端子に供給されるとともに、インバータ回路N3により反転され、アンドゲート回路A02の一方の入力端子に供給される。ナンドゲート回路NA01の他

方の入力端子には、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} のハイレベルからロウレベルへの立ち下がりにおいて、カラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} 及びライトイネーブル信号 \overline{WE} がハイレベルとされかつデータ伝送制御信号 $\overline{DT}/\overline{OE}$ がロウレベルとされることでセットされる図示されないフリップフロップの出力信号 ϕ_{rw} が、遅延な遅延手段（例えば例数値のインバート回路）D を介して供給される。つまり、このフリップフロップの出力信号 ϕ_{rw} は、デュアル・ポート・メモリの読み出しデータ伝送タイトルを指定するためのモード信号として用いられる。これにより、ナンドゲート回路 $NAC1$ の出力信号は、アンドゲート回路 $AC1$ の出力信号 ϕ_{rr} とモード信号 ϕ_{rw} がハイレベルである時にロウレベルとなる。ナンドゲート回路 $NAC1$ の出力信号は、一方において、遅延な遅延手段 D によって遅延された後にインバート回路 $N4$ によって反転された後、ノアゲート回路 $NGO1$ の一方の入力端子に入力される。また、ナンドゲート回路 $NAC1$ の出力信号

は、他方において、そのままノアゲート回路 $NGO1$ の他方の入力端子に入力される。ノアゲート回路 $NGO1$ の出力信号は、タイミング信号 ϕ_{rr} としてポインタ INT に供給される。つまり、このタイミング信号 ϕ_{rr} は、モード信号 ϕ_{rw} がハイレベルとされるデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ伝送モードにおいて、アンドゲート回路 $AC1$ の出力信号 ϕ_{rr} がハイレベルとされるとき、所定の期間だけ一時的にハイレベルとされるものとなる。

一方、アンドゲート回路 $AC2$ の他方の入力端子には、インバート回路 $N1$ 及び $N2$ を介してシリアルクロック信号 SC が供給される。これにより、アンドゲート回路 $AC2$ の出力信号は、アンドゲート回路 $AC1$ の出力信号 ϕ_{rr} がロウレベルでインバート回路 $N2$ の出力信号がハイレベルすなわちカウンタ回路 CTR の計数値が "0" でなく、シリアルクロック信号 SC がハイレベルであるときに、ハイレベルとなる。つまり、アンドゲート回路 $AC2$ の出力信号は、カウンタ回路

CTR の計数値が "0" に達するまでカウンタ回路 CTR をカウントダウンさせるための歩進用タイミング信号 ϕ_{rr} となる。また、インバート回路 $N1$ 及び $N2$ を通ったシリアルクロック信号 SC は、タイミング信号 ϕ_{rr} となる。

第3図には、第4図のタイミング制御回路 TC を含むデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ伝送モードにおける動作を説明するための一実施例のタイミング図が示されている。この図により、この実施例のデュアル・ポート・メモリの読み出し伝送モードの動作を説明する。

第3図において、このデュアル・ポート・メモリは、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} がハイレベルからロウレベルに変化されることによって起動される。このロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりに先立って、カラムアドレスストロブ信号 \overline{CAS} 及びライトイネーブル信号 \overline{WE} がハイレベルとされ、データ伝送制御信号 $\overline{DT}/\overline{OE}$ がロウレベルとされる。また、外部端子 $A0 \sim A1$ にはワード幅を指定するための X アドレス

信号 $Ax0 \sim Ax1$ が供給され、データ入出力用外部端子 $I01 \sim I04$ にはロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりから読み出しデータのシリアル出力動作を開始するまでのシリアルクロック信号 SC のタイトル数 ϕ_{rr} が供給される。

このタイトル数 ϕ_{rr} は、デュアル・ポート・メモリの外部に設けられるメモリ制御回路に含まれる CTR の水平位置検出を制御するためのカウンタ回路の計数値によって決定される。すなわち、1ワード分の読み出しデータの末尾ビットに対応する計数値を $N1$ とし、ロウアドレスストロブ信号 \overline{RAS} を立ち下げる時点での計数値を $N2$ とすると、タイトル数 ϕ_{rr} は、

$$\phi_{rr} = N1 - N2$$

として求められる。このタイトル数 ϕ_{rr} は、以上の式を満足し、かつデュアル・ポート・メモリのランダム・アクセス・ポートにおいて読み出しデータが確立されるまでの期間を超える範囲で、遅延な値に決定される。

ロウアドレスストローブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりにやや遅れて、カラムアドレスストローブ信号 \overline{CAS} がハイレベルからロウレベルに変化される。このカラムアドレスストローブ信号 \overline{CAS} の立ち下がりに先立って、外部端子 $A0 \sim A1$ には、シリアル出力動作において先頭に出力するべきデータ値のアドレスがYアドレス信号 $AY0 \sim AY1$ として供給される。ロウアドレスストローブ信号 \overline{RAS} 、カラムアドレスストローブ信号 \overline{CAS} 、ライトエnable信号 \overline{WE} 及びデータ転送制御信号 $\overline{DT}/\overline{DS}$ は、カウンタ回路CTRの計数値が“0”となりシリアル出力動作が開始された後、ハイレベルに戻る。

デュアル・ポート・メモリでは、ロウアドレスストローブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりによって、Xアドレス信号 $AX0 \sim AX1$ がロウアドレスバッファ $RAD5$ に取り込まれ、ワード線の選択動作が行われる。また、ロウアドレスストローブ信号 \overline{RAS} の立ち下がりによってモーフ信号 ϕ がハイレベルになるとともにタイミング信号 ϕ_{00}

が形成され、データ入出力用外部端子 $I/O1 \sim I/O4$ に供給されるタイトル数 ϕ_{01} がカウンタ回路CTRに取り込まれる。これにより、カウンタ回路CTRの出力は“0”以外の数値となり、第1図のANDゲート回路 $AO1$ の出力信号 ϕ_{02} はロウレベルとされる。このANDゲート回路 $AO1$ の出力信号のロウレベルすなわちインバート回路 $N3$ の出力信号のハイレベルにより、ANDゲート回路 $AO2$ の出力信号すなわちカウンタ回路CTRの歩進用タイミング信号 ϕ_{03} が形成される。カウンタ回路CTRは、このタイミング信号 ϕ_{03} の立ち下がりによって、取り込まれたタイトル数 ϕ_{01} から“0”に向かってカウントダウンを開始する。

カウンタ回路CTRによるシリアルクロック信号SCのカウントダウンが行われている間に、デュアル・ポート・メモリではワード線の選択動作が終了し、選択されたワード線に結合される $m+1$ 番のメモリアルからの読み出しデータがそれぞれ対応する相補データ線上に成立される。また、

カラムアドレスストローブ信号 \overline{CAS} の立ち下がりによって、Yアドレス信号 $AY0 \sim AY1$ が取り込まれ、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDによるデータ転送選択動作が開始される。このシリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDによるデコード処理が終了するタイミングで、タイミング信号 ϕ_{04} が形成され、ポイントPNTのYアドレス信号 $AY0 \sim AY1$ に対応するビットに論理“1”がセットされる。

カウンタ回路CTRによるカウントダウンが進み、その計数値が“0”になると、ANDゲート回路 $AO1$ の出力信号 ϕ_{02} がハイレベルとされる。これにより、まずインバート回路 $N3$ の出力信号がロウレベルとなり、カウンタ回路CTRの歩進用タイミング信号 ϕ_{03} は停止される。また、タイミング信号 ϕ_{01} が形成され、各データ線に成立された読み出しデータがデータレジスタ $DR1 \sim DR4$ に転送される。また、タイミング信号 ϕ_{05} が、シリアル入出力回路 SIO のデータ出力バ

ッファ $DO5$ を制御するシリアル出力制御信号 \overline{DS} に同期して形成される。

タイミング信号 ϕ_{06} のハイレベルにより、シリアル入出力端子 $SIO1 \sim SIO4$ はハイインピーダンス状態 H からYアドレス信号 $AY0 \sim AY1$ によって指定される先頭アドレスの読み出しデータに対応したレベルとされる。これにより、読み出しデータの出力動作が開始される。

タイミング制御回路TCでは、モーフ信号 ϕ 及びANDゲート回路 $AO1$ の出力信号 ϕ_{02} のハイレベルによって、シリアルクロック信号SCに同期したシフト用タイミング信号 ϕ_{07} が形成され、シリアル入出力回路 SIO 及びポイントPNTに供給される。これにより、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDの選択動作によりポイントPNTのYアドレス信号 $AY0 \sim AY1$ に対応するビットにセットされた論理“1”の信号はループ状にシフトされ、データレジスタ $DR1 \sim DR4$ に保持された読み出しデータが、シリアル入出力用相補共通データ線

CS1〜CS4及びシリアル入出力端子S101〜S104に出力される。タイミング信号φによるポイントPNTのシフト動作は、タイミング信号のロウレベルからハイレベルへの立ち上がりと同期して行われる。また、ポイントPNTにおいて、タイミング信号φの先頭パルスは監視され、先頭データの出力時間幅が確保される。

タイミング信号φによる読み出しデータのシリアル出力動作が進み、末尾の読み出しデータの出力が終了すると、シリアル出力制御信号OEがハイレベルに渡される。このシリアル出力制御信号OEのハイレベルによって、モード信号φがロウレベルとされ、シリアル出力用のタイミング信号φがシリアルクロック信号SCの立ち上がりと同期してロウレベルとされる。これにより、デュアル・ポート・メモリのシリアル出力動作は停止され、シリアル入出力端子S101〜S104はハイインピーダンス状態とされる。

以上のように、この実施例のデュアル・ポート

・メモリでは、読み出しデータ転送モードにおいて、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりと同期して、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち上がりから読み出しデータのシリアル出力動作を開始するまでの間のシリアルクロック信号SCのサイクル数CIRSが決定される。このサイクル数CIRSは、タイミング制御回路TCに掛けられるカウンタ回路CTRに初期セットされ、カウントダウンが行われる。カウンタ回路CTRによるカウントダウンが終了し、その計数値が「0」になった時点で、読み出しデータのシリアル出力動作が開始される。このため、外部に掛けられるCTRが高周波化され、表示データのドットレートが非常に高周波化されているにもかかわらず、シリアルクロック信号SCとCTRのスキュータイミングに確実に同期してデュアル・ポート・メモリのシリアル出力動作が行われ、安定した表示画像を得ることが出来るものである。

以上の本実施例に示されるように、この発明を画像処理用メモリとして用いられるデュアル・ポ

ート・メモリ等の半導体記憶装置に適用した場合、次のような効果を得られる。すなわち、

①デュアル・ポート・メモリの読み出しデータ転送モードにおいて、読出制御信号に同期して、読出後から読み出しデータのシリアル出力動作を開始するまでの間のシリアルクロック信号のサイクル数を決定し、タイミング制御回路TCに掛けられるカウンタ回路によってカウントダウンすることと、シリアルクロック信号に同期し安定したタイミングで読み出しデータのシリアル出力動作を開始することが出来るという効果を得られる。

②上記①項により、外部に掛けられるCTRが高周波化され、表示データのドットレートが非常に高周波化されているにもかかわらず、シリアルクロック信号SC及びCTRのスキュータイミングに確実に同期して読み出しデータのリアルタイム転送を行うことができ、安定した表示画像を得ることが出来るという効果を得られる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、この発明は上記実施

例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可変であることはいうまでもない。例えば、第1図のタイミング制御回路TCでは、カウンタ回路CTRをカウントダウンすることによってタイミング調整を行っているが、外部から供給されるシリアルクロック信号SCのサイクル数CIRSをレジスタに保持するとともにカウンタ回路CTRをカウントアップさせ、カウンタ回路CTRの出力とレジスタにセットされるサイクル数CIRSとが一致したときにシリアル出力動作を開始させるようにしてもよい。また、サイクル数CIRSをデコードし、対応付けられるシフトレジスタの対応するビットに論理「1」をセットした後、シリアルクロック信号SCによってシフトレジスタをシフトさせ、この論理「1」が所定の位置に達したことによってシリアル出力動作を開始させる方法もよい。この実施例では、サイクル数CIRSをロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりと同期して供給しているが、コラムアドレスストローブ信号CASの立ち下が

りに同期して供給するものであってもよい。さらに、第2図のデュアル・ポート・メモリは、一つのメモリアレイにより構成されるものであってもよいし、ランダム・アクセス・ポートの入出力回路R10に論理演算回路を設けないなど、そのプロット回路や制御信号の組み合わせ等、種々の実施形態を採りうるものである。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるデュアル・ポート・メモリに適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、例えばシリアル入出力機能を持つ他の各種のマルチ・ポート・メモリにも適用できる。本発明は、少なくともそのシリアル出力動作が外部から供給される制御信号及びクロック信号によって制御される半導体記憶装置には適用できる。

(発明の効果)

本発明において図示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、次のとおりである。すなわち、デュアル・ポート・

メモリの読み出しデータ転送モードにおいて、起動してから読み出しデータのデータ転送動作を開始するまでの間のシリアルクロック信号のタイmingを指定し、タイming制御回路TCに設けられるカウンタ回路によってカウントダウンすること、シリアルクロック信号に同期し安定したタイmingで読み出しデータのシリアル出力動作を開始することができ、読取データのフットレートが高速度化されるにもかかわらず、シリアルクロック信号及びCTRのスキップタイmingに同期した読み出しデータのリアルタイム転送を行うことができる、安定した読取速度を得ることができるとのである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明が適用されたデュアル・ポート・メモリのタイming制御回路の一部の一実施例を示す回路図。

第2図は、第1図のタイming制御回路を含むデュアル・ポート・メモリの一実施例を示すブロック図。

第3図は、第2図のデュアル・ポート・メモリにおける読み出しデータ転送モードの一実施例を示すタイming図。

第4図は、この発明に先立って本発明者等が図示したデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ転送モードを示すタイming図である。

TC・・・タイming制御回路、CTR・・・カウンタ回路、AG1～AG3・・・アンドゲート回路、NAG1・・・ナンドゲート回路、N1～N4・・・インバータ回路。

M-ARY1・・・メモリアレイ、SA1・・・センスアンプ、CSW1・・・カラムスイッチ、RCD・・・ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード、SCD・・・シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード、RADB・・・ロウアドレスバッファ、AMX・・・アドレスマルチプレクサ、CADB・・・カラムアドレスバッファ、REFC・・・リフレッシュアドレスカウンタ、DR1・・・データレジスタ、DSL1・・・データセレクタ、PNT・・・ポ

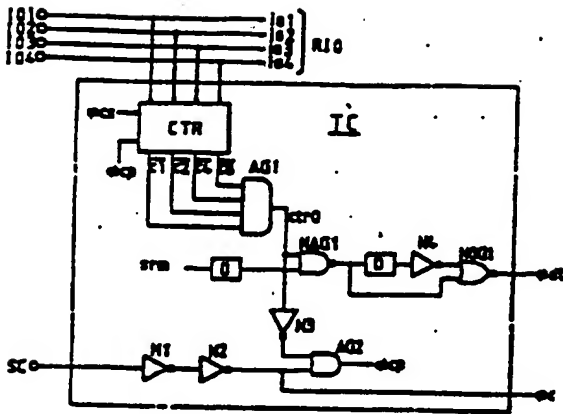
インタ、R10・・・ランダム・アクセス・ポート用入出力回路、PC・・・読取制御回路、S10・・・シリアル・アクセス・ポート用入出力回路。

代理人弁護士

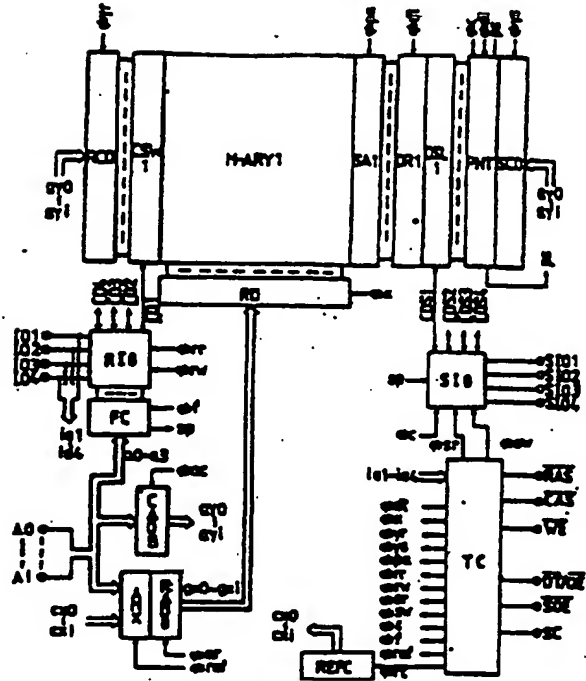
小川 勝男



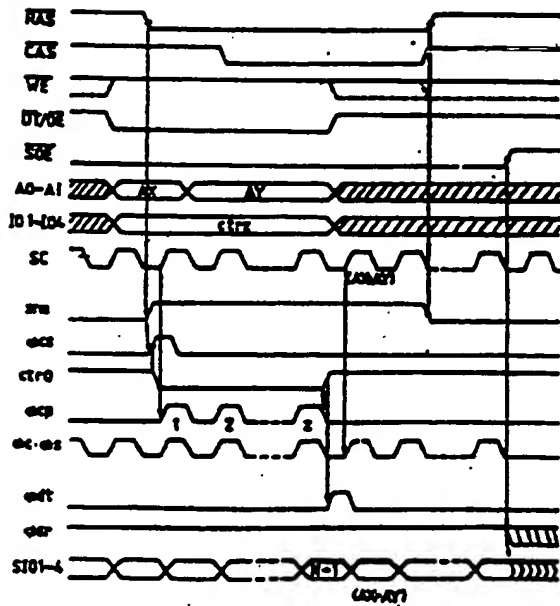
第 1 図



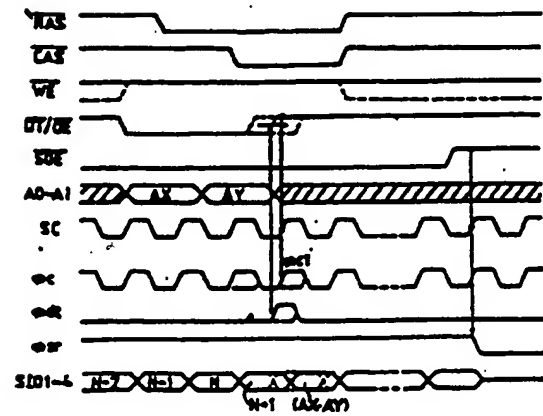
第 2 図



第 3 図



第 4 図



19) Japanese Patent Office (JP)
(11) Patent Application Publication
(12) Laid-Open Patent Publication (A) Sho 63-239676
(51) Int. Cl.⁴ Identification Code Office File No. (43) Publication: October 5, 1988
G11C 11/34 362 G-8522-5B

Examination request: Not requested
No. of inventions: 1
(Total of 14 pages)

(54) Title of the Invention: Semiconductor memory device
(21) Patent Application: Shoe 62-71428
(22) Application: March 27, 1987
(72) Inventor: Yasunori [N.B. Other readings of first name possible.] Yamaguchi
c/o Hitachi, Ltd. Device Development Center
2326 Imai, Oume-shi, Tokyo
(71) Applicant: Hitachi, Ltd.
4-6 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
(74) Agent: Patent agent Masao [N.B. Other readings of first name possible.] Ogawa and one
other

Specifications

1. Title of the invention
Semiconductor memory device
2. Claims
 1. A semiconductor memory device comprising:
a serial-parallel conversion circuit that receives a plurality of read data that is parallelly
output over a plurality of data lines constituting a memory array and provides a serial
output in accordance with a clock signal from an external source; and

a timing control circuit that controls the serial output operation of the aforesaid serial-parallel conversion circuit; and

characterized by:

the timing for starting the aforesaid serial output operation being set at will by specifying the number of cycles of the aforementioned clock signal required between activation by an activation control signal from an external source and the start of the aforementioned serial output operation.

2. A semiconductor memory device described in claim 1 characterized by the aforesaid timing control circuit comprising:

a counter circuit that obtains the aforesaid number of cycles from an external source in synchrony with the aforementioned activation control signal and then performs a count-down operation in accordance with the aforementioned clock signal; and

a timing generation circuit which, upon detection of logical "O" for all bits in the output signal of the aforementioned counter circuit, creates an internal clock signal that is used for a serial output operation.

3. A semiconductor memory device described in claim 1 or claim 2 characterized by:

the aforementioned semiconductor memory device being a dual port memory; and

the aforementioned number of cycles being provided over a plurality of data input/output terminals for random access port use.

3. Detailed description of the invention

Field of industrial use

The present invention relates to semiconductor memory devices and in particular to an art that is effective, for example, when used with a dual port memory that is used for image processing and possessing both a random input/output function and a serial input/output function.

Prior art

A description of a frame buffer memory used with images to display characters, graphics, etc. on a CRT (cathode ray tube) screen is found, for example, in pages 243 through 264 of "Nikkei Electronics" dated March 24, 1986 published by Nikkei McGraw-Hill.

The dual port memory described in the aforesaid literature is provided with a random access port that is used for the input and output of memory data in one-bit units or several-bit unites, and a serial access port that is used for the serial input and output of memory data in units of word lines in a memory array.

Problems to be solved with the present invention

As Fig. 4 shows, a dual port memory such as the above is provided with, as external control signals, row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$, column address strobe signal $\overline{\text{CAS}}$ and write enable signal $\overline{\text{WE}}$ and additionally, for example, data transfer control signal $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$, serial output control signal $\overline{\text{SOE}}$ and serial clock signal SC. With a dual port memory, the read data transfer mode - where the read data is serially output - is recognized when the levels of the column address strobe signal $\overline{\text{CAS}}$ and write enable signal $\overline{\text{WE}}$ are high and the level of the data transfer control signal $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$ is low when the level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$ changes from high to low. At this time, the address AX of the word line to be read is provided to external terminals A0 through Ai in synchrony with the level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$ rising to high, and the read signals from the

memory cells that are connected to the selected word line are set up in the data lines. Also, in synchrony with the level of the column address strobe signal $\overline{\text{CAS}}$ falling to low which occurs with a slight delay following the level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$ becoming low, the address AY of the first column that is to be serially output is supplied to external terminals A0 through Ai.

Thereafter, when the level of the data transfer control $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$ is set back to high, timing signal ϕ_{dt} is generated - the timing signal ϕ_{dt} is used to transfer to the data register of the serial access port the read data that had been parallelly output to each of the data lines - and, along with that, an output operation is begun for the new serial data (data following (AX · AY)) that had been transferred to the data register in accordance with the timing signal ϕ_c which is generated in synchrony with the serial clock signal SC.

After the level of the data transfer control signal $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$ is once set to low, the serial output operation begins when the level returns to high. The timing for this is controlled by monitoring the output signal of a counter circuit which counts the horizontal pixel location and which is provided in an external memory control circuit that drives the said dual port memory. To explain, when the output of the read data in the memory cells that are connected to one word line in a dual port memory is near completion, the dual port memory is reactivated and the read data in the memory cells of the new word line is output to the corresponding data lines. Thereafter, the level of the data transfer control signal $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$ is returned to high while monitoring when the level of the serial clock signal SC becomes low which happens when the value of the counter circuit in the memory control circuit shows the end of the serial output operation for the read data from the memory cells connected to the preceding word line that had been selected. This then causes the read data in the memory cells that are connected to

the newly selected word line to be transferred to the data register and initiates a serial output operation. This allows a real time data transfer in synchrony with the CRT's dot rate.

However, improvements in display technology have resulted in the development of high-resolution CRTs which have increased the dot rate that determines the rate at which display data is serially output. This has resulted in a difficulty in maintaining a synchrony between the rising of the level of the data transfer control $\overline{DT} / \overline{OE}$ and the serial clock signal SC. To explain, as described earlier, the timing for returning the level of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ to high is determined by monitoring the output signal of the counter circuit in the memory control circuit. This means that as the delay time involved in advancing the counter circuit using the serial clock signal SC, and the delay time involved in decoding and monitoring the output signal from the counter circuit begin to increase relative to the period of the serial clock signal SC, raising the level of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ in synchrony with the serial clock signal SC becomes difficult. As the dotted line in Fig. 4 shows, this results in a timing mismatch between the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ and the serial clock signal SC, and in particular, a delay in the level of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ rising with respect to the rise in the level of the serial clock signal SC. This then results in shortening the duration of the timing signal ϕdt which is used for transferring to the data register the read data from the memory cells that are connected to the newly selected word line. This results in an unstable serial data transfer operation and a disruption of the displayed images.

It is the object of the present invention to provide a semiconductor memory device such as a dual port memory with a stable serial data transfer operation.

The aforementioned object and other objects of the present invention and its new features will become apparent from the description in the specification and the attached figures.

Means for solving the problems

The following is a brief description of an overview of a representative embodiment among the embodiments disclosed in the present application. To explain, during data transfer in a dual port memory, the timing for starting the transfer of data to the data register is set at will by specifying the number of clock signal cycles required between the activation of the data transfer cycle and the initiation of the transfer operation.

Operation

When the data transfer operation is about to start in a dual port memory, the aforesaid means allows the clock signal position where the data transfer operation is to begin to be specified at will in accordance with the counter value of a counter circuit in a memory control circuit. Furthermore, since a count-down counter circuit provided within a dual port memory is used to perform the transfer operation in synchrony with a clock signal, a semiconductor memory device such as a dual port memory with a stabilized display data transfer operation is realized.

Embodiments

Fig. 2 shows a block diagram of one embodiment of a dual port memory where the present invention is applied. The respective circuit blocks shown in the said figure are typically formed on, although not restricted to, a single semiconductor substrate such as a single crystal silicon using semiconductor integrated circuit fabrication technology of the public domain.

The dual port memory of this embodiment is provided with a random access port that is accessed in units of 4 bits and whose basic structural element is a dynamic RAM, and a serial access port where memory data is serially input and output in units of a word line. This allows the dual port

memory to engage in a series of serial input/output operations simultaneous with accesses made to the random access port. Also, although not restricted by this, a random input/output circuit RIO that is included in the random access port is provided with a logical operation circuit for performing raster operations, etc. A function control circuit that controls the said logical operation circuit is also provided. The logical operation circuit is provided with various operation functions such as logical multiplication and logical addition, and which operation to perform is specified with a [logical] operation code which is specified by particular combinations of the control signals which are input through external terminals A0 through A3 for the address signals.

The serial access port is provided with a serial input/output circuit SI0. Ordinarily, memory data corresponding to four memory arrays are simultaneously and serially input and output through four serial input/output terminals SI01 through SI04. However, a specific combination of [logical] operation codes can be used to specify the use as a memory with a x1 bit configuration wherein read data that are output from the four memory arrays are alternately output from input/output terminal SI01.

From an external device, in addition to row address strobe signal \overline{RAS} , column address strobe signal \overline{CAS} , write enable signal \overline{WE} and other control signals which are used in ordinary dynamic RAMs, the dual port memory is provided with data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ which is used for output control and for controlling the data transfer between the random access port and the serial access port, the serial output control signal \overline{SOE} which is used for controlling the switching between input and output operations by the serial access port, and the serial clock signal SC which is used as a synchronization signal during serial input and output operations.

Although not restricted by this, this embodiment of the dual port memory is provided with four memory arrays, M-ARY1 through M-ARY4, and sense amplifiers SA1 through SA4 and column

switches CSW1 through CSW4 which correspond to the respective memory arrays. A column address decoder RCD and a row address decoder RD, common to memory arrays M-ARY1 through M-ARY4, are also provided. A plurality of such address decoders may be provided depending on the arrangement of the memory arrays on a semiconductor substrate. Fig. 2 shows memory array M-ARY1 and its peripheral circuitry for illustration purposes.

In Fig. 2, memory array M-ARY1 comprises $(m + 1)$ word lines that are arranged in a direction perpendicular to the said figure, $(n + 1)$ sets of complementary data lines arranged in a direction horizontal with the said figure, and $(m + 1) \times (n + 1)$ pieces of memory cells which are located at the intersections of the said word lines and complementary data lines.

The dynamic memory cells which configure the memory array M-ARY1 are constructed of capacitors for data storage and MOSFETs for address selection. The gates of the MOSFETs for address selection for the $(n + 1)$ pieces of memory cells that are arranged along the same row are connected to the corresponding word line. Each word line is furthermore connected to the row address decoder RD so that one word line that is specified by the X address signal AX0 through AXi is specified and selected.

The row address decoder RD decodes the complementary internal address signals $\underline{ax0}$ through \underline{axi} (here the internal address signal, for example, $\underline{ax0}$) with the same phase and the internal address signal $\overline{ax0}$ with the opposite phase as the X address signal AX0 that is supplied from an external source are collectively represented as complementary internal address signal $\underline{ax0}$; the same convention is used hereinafter) that are supplied by row address buffer RADB, selects one word line that is specified by the X address signals AX0 through AXi and sets the selection state level to high. The selection operation of a word line by the row address decoder RD is performed in accordance with the word line selection timing signal ϕx that is supplied by the timing control circuit TC.

The row address buffer RADB receives the row address signal from address multiplexer AMX, forms complementary internal address signals $\bar{a}x0$ through $\bar{a}xi$ and supplies the signals to the row address decoder RD. The dynamic RAM of this embodiment uses the so-called address multiplex method wherein the X address signals AX0 through AXi which specify the row address and the Y address signals AY0 through AYi which specify the column address are time-division multiplexed and supplied through the same external terminals A0 through Ai. The X address signals AX0 through AXi which are supplied from an external source as control signals are fed to external terminals A0 through Ai in synchrony with the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falling, and the Y address signals AY0 through AYi which are supplied from an external source as control signals are fed to external terminals A0 through Ai in synchrony with the level of the column address strobe signal \overline{CAS} falling. Furthermore, the dynamic RAM of this embodiment is provided with an automatic refresh mode wherein data stored in the memory cells are read and rewritten using a prescribed period. Therefore, a refresh address counter REFC is provided to specify the word line to be refreshed in the automatic refresh mode.

In accordance with the timing signal ϕ_{ref} which is provided by the timing control circuit TC, the address multiplexer AMX selects the X address signals AX0 through AXi that are supplied via external terminals A0 through Ai and the refresh address signals $\bar{c}x0$ through $\bar{c}xi$ supplied by refresh address counter REFC and transfers the signals to row address buffer RADB as row address signals. To explain, when the level of the timing signal ϕ_{ref} is low meaning an ordinary memory access mode, the address multiplexer AMX selects the X address signals AX0 through AXi that are supplied by an external device via external terminals A0 through Ai; when the level of the timing signal ϕ_{ref} is high meaning an automatic refresh mode, the address multiplexer AMX selects the refresh address signals $\bar{c}x0$ through $\bar{c}xi$ that are supplied by the refresh address counter REFC.

As afore-described, since the X address signals AX_0 through AX_i are supplied to external terminals A_0 through A_i in synchrony with the falling level of the row address strobe signal \overline{RAS} , the row address signals are obtained by the row address buffer RADB in accordance with the timing signal ϕ_{ar} which is generated by the timing control circuit TC by detecting the falling level of the row address strobe signal \overline{RAS} .

The drains of the MOSFETs used for selecting the addresses of the memory cells that are formed along the same column in memory array M-ARY1 are connected to the corresponding complementary data line. One end of each complementary data line in memory array M-ARY1 is connected to the corresponding switch MOSFET of the column switch CSW1 and, furthermore, is selectively connected to the complementary common data line $\overline{CD}1$ (here the noninverting signal line $CD1$ and inverting signal line $\overline{CD}1$ of the complementary common data line are collectively represented as complementary common data line $\overline{CD}0$; the same convention is used hereinafter.)

The column switch CSW1 comprises $(n + 1)$ pairs of switch MOSFETs which are connected to their corresponding complementary data lines. The other ends of these switch MOSFETs are commonly connected to the noninverting signal line $CD1$ or inverting signal line $\overline{CD}1$ which constitute the complementary common data line. This allows the column switch CSW1 to selectively connect $(n + 1)$ sets of complementary data with common complementary data line $\overline{CD}1$. The gates of the two switch MOSFETs in each pair which constitute the column switch CSW1 are commonly connected and are provided with the data line selection signal which is created by the column address decoder RCD for the random access port.

The column address decoder RCD for the random access port decodes the complementary internal address signals ay_0 through ay_i that are supplied by the column address buffer CADB, and, in accordance with the data line selection timing signal ϕ_{yr} supplied by the timing control circuit TC,

forms the aforementioned data line selection signal which is then supplied to column switches CSW1 through CSW4.

The timing control circuit TC detects the falling level of the column address strobe signal $\overline{\text{CAS}}$ and generates the corresponding signal ϕ_{ac} . In accordance with the signal ϕ_{ac} , the column address buffer CADB receives and holds the Y address signals AY0 through AYi supplied through external terminals A0 through Ai and forms the complementary internal address signals $\text{ay}0$ through $\text{ay}i$ which are then supplied to the column address decoder RCD for the random access port.

The other ends of each complementary data lines in memory array M-ARY1 are connected to the corresponding unit circuits of sense amplifier SA1 and furthermore to the corresponding unit circuits of data register DR1 of the serial access port.

Latches comprising two cross-connected CMOS inverter circuits are used as the basic structural elements of the unit circuits in sense amplifier SA1. Each of the said sense amplifier unit circuits is set in the operation mode by the timing signal ϕ_{pa} which is supplied by the timing control circuit TC, amplifies the micro-signals that are read from a memory cell and output to its corresponding complementary data line, and forms a binary signal with a high level or a low level.

The complementary common data line $\overline{\text{CD}}1$ to which the complementary data line that is specified by the Y address signals AY0 through AYi is selectively connected is connected to the input/output circuit RIO for the random access port. Complementary common data lines $\overline{\text{CD}}2$ through $\overline{\text{CD}}4$ which are provided corresponding to memory arrays M-ARY2 through M-ARY4 are similarly connected to the random access port input/output circuit RIO.

When the dual port memory is in the random access port write operation mode, the random input/output circuit RIO, which is set in the operation mode by the timing signal ϕ_{rw} supplied by the timing control circuit TC, receives write data from an external device through input/output terminals

IO1 through IO4 and transfers the said write data as complementary write signals to the complementary common data lines $\overline{CD1}$ through $\overline{CD4}$. Furthermore, when the dual port memory is in the random access port read operation mode, the random input/output circuit RIO, which is set in the operation mode by the timing signal ϕ_{RT} supplied by the timing control circuit TC, receives binary signals that are read from the memory cells over complementary common data lines $\overline{CD1}$ through $\overline{CD4}$, amplifies the said binary signals and then outputs the said binary signals from input/output terminals IO1 through IO4. Although not restricted by this, the said random input/output circuit RIO is provided with a logical operation circuit that uses the read/modify/write function to perform various [logical] operations between the input data and data read from the memory cells and then rewrites the results. The said logical operation circuit is provided with various [logical] operation modes for performing processes such as a raster operation.

The operation mode of the logical operation circuit is specified by the function control circuit FC which comprises a register for holding the operation codes which are supplied through external terminals A0 through A3 and a decoder which decodes the said operation codes and selects and specifies the operation mode of the logical operation circuit. When the level of the column address strobe signal \overline{CAS} is set to low before the row address strobe signal \overline{RAS} is, and if the level of the write enable signal \overline{WE} is low at the same time, the operation codes are supplied to the dual port memory via external terminals A0 through A3. Furthermore, the specific combinations of the operation codes are used as internal control signal sp which sets the output of the serial input/output circuit SIO described hereinbelow in the so called x1 bit configuration.

As described hereinbelow, when the dual port memory is in the serial read operation mode, the external terminals IO1 through IO4 for data input and output are provided with the number of cycles of the serial clock signal SC required for starting the serial output operation after the serial read

operation mode is activated. With the dual port memory of this embodiment, this arrangement allows the timing when the serial output mode will begin after its activation to be set at will and enables a serial output operation that is synchronized in a stable manner with the serial clock signal SC whose period will be short when the dot rate is high. The data on the number of cycles that is supplied to external data input/output terminals IO1 through IO4 is sent to timing control circuit TC as internal signals io1 through io4.

The serial access port of the dual port memory of this embodiment comprises data registers DR1 through DR4 of $(n + 1)$ bits corresponding to the complementary data lines in each memory arrays, data selectors DSL1 through DSL4, pointer PNT, column address decoder SCD for the serial access port and serial input/output circuit SIO, the latter three being commonly provided for the aforesaid four data registers and data selectors. Incidentally, depending on the layout of the memory arrays on a semiconductor substrate, a plurality of pointers PNT and a plurality of the column address decoders SCD for the serial access port may be provided.

Corresponding to the complementary data lines in the memory array M-ARY1, the data register DR1 includes $(n + 1)$ pieces of flip-flops for data latching purpose. Switch MOSFETs for data transfer use are provided between the input/output nodes of the said flip-flops and their corresponding noninverting signal line and inverting signal line of the complementary data lines. Timing signal ϕ_{dt} for data transfer use output by the timing control circuit TC is supplied to the gates of the aforesaid MOSFETs.

Each bit of the data register DR1 is connected to its corresponding switch MOSFET of data selector DSL1. The data selector DSL1, which is similarly constructed as the afore-described column switch SW1, selectively connects each bit of the data register DR1 with the complementary common data line CDS1 used for serial input and output. The gates of each pair of switch MOSFETs of data

selector DSL1 are commonly connected and are provided with the register selection signal from pointer PNT.

The pointer PNT comprises a latch circuit (pointer latch) which holds the serial operation start bit that is specified by the column address decoder SCD for the serial access port, shift register with $(n + 1)$ bits, and a switch circuit consisting of an n-channel MOSFET that is provided between the aforesaid latch circuit and the aforesaid shift register. The output terminal ps for the last bit in the said shift register is connected to the input terminal for the first bit. Furthermore, the aforesaid timing signal ødt is commonly supplied to the gates of the aforesaid switch MOSFETs. When the dual port memory is in the serial input/output mode, the shift register of pointer PNT engages in a looping shift operation in accordance with the shift clock timing signal øc that is supplied by the timing control circuit TC. The selection signal that is held by the pointer latch circuit is supplied to the shifter register as its initial value when the level of the timing signal ødt becomes high.

The column address decoder SCD for the serial access port decodes the complementary internal address signals ay0 through ayi which are supplied by the column address buffer CADB and sets only the bit of pointer PNT corresponding to the first bit of the serial input/output specified by the Y address signals AY0 through AYi to a logical "1." To elaborate, when the serial input/output mode is being used, the word line si selected by the X address signals AX0 through AXi, and Y address signals AY0 through AYi specify the address of the first column where the serial input and output is to be performed. The logical "1" signal that is written to the specified bit of pointer PNT by the column address decoder SCD for the serial access port is shifted in a loop inside pointer PNT in accordance with timing signal øc. The said shifting of the logical "1" signal results in a register selection signal with a high level to be sequentially supplied to the data selector DSL1. This then results in each bit of data register DR1 to be successively connected to the complementary common data line CDS1 used

for serial input and output. With the dual port memory of the present embodiment, this arrangement allows the serial input and output of the memory data to be started from any desired column address which in turn allows processes like scrolling on an image memory to be performed at a high speed.

In the foregoing manner, when the dual port memory is in the serial read operation mode, the $(n + 1)$ bits of read data that are output over $(n + 1)$ sets of complementary data lines in memory array M-ARY1 are stored in data register DR1 when the level of timing ϕ_{dt} becomes high. At the same time, with respect to pointer PNT, when the level of timing ϕ_{dt} becomes high, the selection signal that is held by the pointer latch is transferred to the shift register as the initial value. In accordance with the register selection signal that is successively sent from pointer PNT, read data is sent to the serial input/output circuit SIO via the complementary common data line $\underline{CDS1}$ for serial input and output. On the other hand, when the dual port memory is in the serial write operation mode, the write data which is serially sent from serial input/output terminal SIO1 via serial input/output circuit SIO is sequentially provided to the corresponding bit of the data register DR1 in accordance with the register selection signal that is successively sent from pointer PNT. When the level of timing ϕ_{dt} changes to high, the write data which was stored in data register DR1 is written, all at once, to the $(n + 1)$ pieces of memory cells which are connected to the selected word line in memory array M-ARY1.

The serial input/output circuit SIO includes a data input buffer, a data output buffer and four main amplifiers which are provided corresponding to serial input/output terminals SIO1 through SIO4 and complementary common data lines $\underline{CDS1}$ through $\underline{CDS4}$ used for serial input and output. When the dual port memory is in the read data transfer mode, the data output buffer of the serial input/output circuit SIO is set in the operation mode when the level of the timing signal ϕ_{sr} from the timing control circuit TC becomes high, and the data that is output over the corresponding complementary common data lines $\underline{CDS1}$ through $\underline{CDS4}$ for serial input and output and then amplified by the corresponding

main amplifiers is output to an external device using the serial input/output terminals SIO1 through SIO4. When the dual port memory is in the serial write operation mode, the data input buffer of the serial input/output circuit SIO is set in the operation mode when the level of the timing signal ϕ_{sw} from the timing control circuit TC becomes high, and the write data that is supplied from an external device over the corresponding serial input/output terminals SIO1 through SIO4 is transferred as complementary write data signals to the corresponding complementary common data lines $\overline{CDS1}$ through $\overline{CDS4}$ for serial input and output. The serial input/output circuit SIO performs the serial input and output operation on the memory data in accordance with timing signal ϕ_c which is generated by the timing control circuit TC based on a serial clock signal SC that is supplied from an external source.

As described above, with the dual port memory of this embodiment, the serial output signal of the serial input/output circuit SIO is ordinarily output four bits at a time using the four serial input/output terminals SIO1 through SIO4. However, to realize a serial memory with a larger memory capacity, it is possible to use the dual port memory as a memory which the so-called x1 bit configuration where data that is read and output from four memory arrays, M-ARY1 through M-ARY4, is serially output through one serial input/output terminal. In this case, as mentioned earlier, one of the combinations of the operation codes which control the operation mode of the logical operation circuit in the random input/output circuit RIO is used as internal control signal ϕ_p which specifies a x1 bit configuration for the serial output. When the level of the said internal control signal ϕ_p from the function control circuit FC becomes high, a multiplexer that is provided in the serial input/output circuit SIO sequentially selects the read data that is serially output over the four sets of serial input/output complementary common data lines $\overline{CDS1}$ through $\overline{CDS4}$ and outputs to an external device using one serial input/output terminal SIO1. Since this serial output is performed in accordance

with timing signal ϕc from the timing control circuit TC, the data rate becomes the same as what the data rate would be for each input/output terminal had the four serial input/output terminals SIO1 through SIO4 been used to perform a serial output four bits at a time.

The timing control circuit TC receives from an external source, as control signals, row address strobe signal \overline{RAS} , column address strobe signal \overline{CAS} , write enable signal \overline{WE} , data transfer control signal DT/OE, and serial output control signal \overline{SOE} and forms the various aforesaid timing signals and supplies them to the different circuits. The timing control circuit also uses the serial clock signal SC supplied from an external source to generate the timing signal ϕc which is used for synchronizing the serial input/output operation and supplies the said signal to the serial input/output circuit SIO.

The operation mode of the dual port memory is specified by suitably combining the various control signals. For example, if the level of the row address strobe signal \overline{RAS} is low already and if, when the level of the column address strobe signal \overline{CAS} becomes low, the level of the write enable signal \overline{WE} is high, the ordinary read operation mode using the random access port is selected. If the level of the row address strobe signal \overline{RAS} is low already and if, when the level of the column address strobe signal \overline{CAS} becomes low, the level of the write enable signal \overline{WE} is low, the ordinary write operation mode using the random access port or the [logical] operation write operation mode is selected. Furthermore, if, when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls, the level of the write enable signal \overline{WE} is high and the level of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ is low, the read data in the memory array is transferred to data registers DR1 through DR4, and the so-called data transfer mode is selected for serially reading the data.

As described above, when the dual port memory of the present embodiment is in the data transfer mode, when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls to low, in synchrony with

this change in level; the number of cycles of the serial clock signal SC required from activation until the start of the next data transfer operation on the serial read data is set in external terminals IO1 through IO4 used for data input and output. Because of this, the timing control circuit TC is provided with counter circuit CTR which receives the data on the number of cycles via the data input/output terminals IO1 through IO4 and performs a count-down operation in accordance with the serial clock signal SC. The read data that is output to the respective data lines is transferred to data registers DR1 through DR4 in accordance with the timing signal ϕ_{dt} which is generated when the value of counter circuit CTR in the timing control circuit TC becomes "0." The said data is then output by the serial input/output circuit SIO to the outside via serial input/output terminals SIO1 through SIO4 in accordance with the timing signal ϕ_c .

Next, if, when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls, the levels of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ and the write enable signal \overline{WE} are both low and the level of the serial input/output control signal \overline{SOE} is high, the timing control circuit TC sets the dual port memory in the serial write operation mode, and the serial write data that is supplied via serial input/output terminals SIO1 through SIO4 is fed to data registers DR1 through DR4. On the other hand, if, when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls, the levels of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ and the write enable signal \overline{WE} are both low and the level of the serial input/output control signal \overline{SOE} is also low, the write data transfer mode is selected, and the transfer timing signal ϕ_{dt} is generated. This sets the transfer switch MOSFETs of data registers DR1 through DR4 in an ON state. This results in the afore-described serial write operation mode, and the write data stored in data registers DR1 through DR4 are fed all at once to $(n + 1)$ bits of memory cells that are connected to the selected word line in the memory array. The serial write operation using the serial access port of a dual port memory

is realized by executing the write data transfer mode in combination after executing the afore-described serial write operation mode.

On the other hand, if the level of the column address strobe signal $\overline{\text{CAS}}$ changes from high to low before the level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$ falls to low, the so-called $\overline{\text{CAS}}$ before RAS refresh mode is selected. Also, if the level of the write enable signal $\overline{\text{WE}}$ is already low when the level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$ falls, the [logical] operation mode setting cycle is selected, and the [logical] operation code which is supplied via external terminals A0 through A3 is stored in the register in the function control circuit FC.

With all of the operation modes other than the afore-described [logical] operation mode setting cycle, the X address signals AX0 through AXi which specify the word line are supplied to the external terminals A0 through Ai in synchrony with the falling level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$. Also, if a particular operation mode requires a column address, the Y address signals AY0 through AYi which specify the complementary data line are supplied to the external terminals A0 through Ai in synchrony with the falling level of the column address strobe signal $\overline{\text{CAS}}$.

Fig. 1 shows a circuit diagram of a part of one embodiment of the timing control circuit TC for a dual port memory shown in Fig. 2.

As previously stated, with the dual port memory of this embodiment, the data input/output external terminals IO1 through IO4 are used to specify, using a binary representation, the number of cycles of the serial clock signal SC that is required from the activation of the dual port memory by the level of the row address strobe signal $\overline{\text{RAS}}$ becoming low until the start of the data transfer operation on the read data. The said number of cycles is supplied as internal data io1 through io4 to the corresponding bits in the counter circuit CTR in the timing control circuit TC.

Another timing generating circuit is provided within timing control circuit TC, and from the said other timing generating circuit, the counter circuit CTR receives the timing signal ϕ_{cs} which is generated in synchrony with the falling level of the row address strobe signal \overline{RAS} . The counter circuit CTR also receives the [counter] advancing timing signal ϕ_{cp} which is created within the timing control circuit TC shown in the said figure.

The inverted output signals $\overline{C1}$ through $\overline{C8}$ from each bit in the counter circuit CTR are supplied to the four input terminals of the AND gate circuit AG1. The level of the output signal $ctr0$ of the AND gate circuit AG1 is set to high when the inverted output signals $\overline{C1}$ through $\overline{C8}$ of the counter circuit CTR are all logical "0," that is, when the value of the counter circuit CTR becomes "0."

The output signal $ctr0$ of the AND gate circuit AG1 is fed to one input terminal of the NAND gate circuit NAG1 and, after the said output signal has been inverted by inverter circuit N3, also to one input terminal of the AND gate circuit AG2. The other input terminal of the NAND gate circuit NAG1 receives the output signal srm from a flip-flop which is not illustrated after the said output signal srm has passed through a suitable delay means (for example, an even number of inverter circuits). The said output signal srm from the flip-flop which is not illustrated is set if, when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls from high to low, the levels of the column address strobe signal \overline{CAS} and the write enable signal \overline{WE} are high and the level of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ is low. In other words, the output signal srm of the said flip-flop is used as a mode signal which specifies the read data transfer cycle of the dual port memory. Given this setup, the level of the output signal of the NAND gate circuit NAG1 becomes low when the levels of the output signal $ctr0$ of the AND gate circuit AG1 and the mode signal srm are high. The output signal of the NAND gate circuit NAG1 is delayed by a suitable delay means D, inverted by inverter circuit N4 and then fed to one of the input terminals of the NOR gate circuit NOG1 while the output signal of the NAND gate

circuit NAG1 is also fed directly to the other input terminal of the NOR gate circuit NOG1. The output signal of the NOR gate circuit NOG1 is fed to pointer PNT as timing signal ϕdt . In other words, when the level of the mode signal srm is high which means that the dual port memory is in the read data transfer mode, the level of the timing signal ϕdt is temporarily set to high for a prescribed amount of time when the level of the output signal ctr0 of the AND gate circuit AG1 is high.

Serial clock signal SC that has passed through inverter circuits N1 and N2 is fed to the other input terminal of the AND gate circuit AG2. This means that the level of the output signal of the AND gate circuit AG2 becomes high when the level of the output signal ctr0 of the AND gate circuit AG1 is low, the level of the output signal of the inverter circuit N3 is high, that is, when the value of the counter circuit CTR is not "0," and the level of the serial clock signal SC is high. In other words, the output signal of the AND gate circuit AG2 serves as a timing signal ϕcp which advances and counts down the counter circuit CTR until the value of the counter circuit CTR becomes "0." Also, the serial clock signal SC that has passed through inverter circuits N1 and N2 becomes timing signal ϕc .

Fig. 3 shows a timing chart of one embodiment which is used to explain the operation of the read data transfer mode for a dual port memory that includes the timing control circuit TC shown in Fig. 4 [sic]. An overview of the read transfer mode of the dual port memory of this embodiment is explained with reference to Fig. 3.

In Fig. 3, the dual port memory is activated when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} changes from high to low. Prior to the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falling from high to low, the levels of the column address strobe signal \overline{CAS} and write enable signal \overline{WE} are set to high, and the level of the data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ is set to low. The X address signals AX0 through AXi which specify the word line are fed to the external terminals A0 through Ai, and the number of serial clock signal SC cycles ctrz which must elapse between the level of the row address

strobe signal \overline{RAS} falling and the start of the serial output operation on the read data is fed to external terminals IO1 through IO4 used for data input and output.

The number of cycles ctrz is determined by the counter value of a counter circuit which is included in a memory control circuit that is external to the dual port memory and which is used for controlling the horizontal pixel location on a CTR [sic]. To explain, letting N1 represent the counter value corresponding to the last bit in one word line worth of read data and N2 represent the counter value when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} is to fall, the number of cycles ctrz is determined as follows:

$$ctrz = N1 - N2$$

The number cycles ctrz is set to a suitable value that satisfies the above equation while providing more time than is necessary to set a read data in the random access port of a dual port memory.

The level of the column address strobe signal \overline{CAS} changes from high to low with a slight delay after the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls. Prior to the level of the column address strobe signal \overline{CAS} falling from high to low, the address of the data line that should be output first during a serial output operation is supplied to external terminals A0 through Ai as Y address signals AY0 through AYi. The levels of the row address strobe signal \overline{RAS} , column address strobe signal \overline{CAS} , write enable signal \overline{WE} and data transfer control signal $\overline{DT} / \overline{OE}$ are returned to high after the counter value of the counter circuit CTR has become "0" and the serial output operation has been started.

With the dual port memory, when the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls, the X address signals AX0 through AXi are stored in the row address buffer RADB, and a word line selection operation is performed. When the level of the row address strobe signal \overline{RAS} falls, the level

of the mode signal srm is set to high, the timing signal ϕcs is generated, and the number of cycles $ctrz$ which is supplied to external terminals IO1 through IO4 used for data input and output are stored in the counter circuit CTR. This makes the output of the counter circuit CTR to a value other than "0," and the level of the output signal $ctr0$ of the AND gate circuit AG1 shown in Fig. 1 becomes low. When the level of the output signal of the said AND gate circuit AG1 becomes low, that is, when the level of the output signal of the inverter circuit N3 becomes high, the output signal of the AND gate circuit AG2, that is, the timing signal ϕcp for advancing the counter circuit CTR is generated. Whenever the level of the said timing signal ϕcp becomes low, the counter circuit CTR counts down from the value of the number of cycles $ctrz$ that was initially stored toward the value of "0."

While the counter circuit CTR is counting down the serial clock signal SC, the word line selection operation is completed in the dual port memory, and the data that is read from the $(n + 1)$ memory cells that are connected to the selected word line is set in their corresponding complementary data lines. Also, when the level of the column address strobe signal \overline{CAS} falls, the Y address signals $AY0$ through AYi are received, and the column address decoder SDC for the serial access port begins selecting a data line. At the same time that the said column address decoder SCD for the serial access port completes the decoding process, the timing signal ϕys is created, and a logical "1" is set in the bits of pointer PNT corresponding to the Y address signals $AY0$ through AYi .

As the counter circuit CTR counts down and when the counter value become "0," the level of the output signal $ctr0$ from the AND gate circuit AG1 becomes high which causes the level of the output signal of the inverter circuit N3 to become low and stops the timing signal ϕcp which is used for advancing the counter circuit CTR. Also, timing signal ϕdt is created and the read data that had been set in each of the data lines is transferred to data registers DR1 through DR4. Furthermore, timing

signal ϕ_{sr} is generated in synchrony with the serial output control signal \overline{SOE} which controls the data output buffer DOB of the serial input/output circuit SIO.

With the timing signal ϕ_{sr} at a high level, the serial input/output terminals SIO1 through SIO4 changes from a high-impedance state H_z to a level commensurate with the read data in the first address specified by Y address signals AY_0 through AY_i . This commences the output operation of the read data.

With the levels of the mode signal srm and the output signal ctr_0 of the AND gate circuit AG1 being high, the timing control circuit TC generates timing signal ϕ_c which is used for shifting and is synchronized with the serial clock signal SC. The said timing signal ϕ_c is supplied to the serial input/output circuit SIO and the pointer PNT. This causes the logical "1" signal that had been set by the selection operation of the column address decoder SCD for the serial access port in the bits of pointer PNT corresponding to the Y address signals AY_0 through AY_i to shift in a loop. This causes the read data that had been stored in data registers DR1 through DR4 to be output to serial input/output terminals SIO1 through SIO4 via the serial input/output circuit SIO and the complementary common data lines $\overline{CDS}1$ through $\overline{CDS}4$ for serial input/output use. The shifting of the pointer PNT with the timing signal ϕ_c happens in synchrony with the level of the said timing signal rising from low to high. The pointer PNT ignores the first pulse from the timing signal ϕ_c so as to secure an output time width for the first data.

As the serial output operation for the read data progresses as dictated by the timing signal ϕ_c and when the last read data is output, the level of the serial output control signal \overline{SOE} is returned to high which causes the level of the mode signal srm to become low which, in turn, causes the level of the serial output timing signal ϕ_{sr} to be set to low in synchrony with the level of the serial clock signal

SC rising to high. This stops the serial output operation of the dual port memory, and the serial input/output terminals SIO1 through SIO4 are set in a high-impedance state.

As the foregoing description shows, when the dual port memory of the present embodiment is in the read data transfer mode, the number of cycles $ctrz$ of the serial clock signal SC required between the level of the row address strobe signal \overline{RAS} becoming low and the start of the serial output operation of the read data is specified in synchrony with the level of the row address strobe signal \overline{RAS} becoming low. The said number of cycles $ctrz$ is set in the counter circuit CTR in the timing control circuit TC as an initial value for starting the count down operation. When the counting down by the counter circuit CTR ends and the counter value become "0," the serial output operation of the read data is begun. This allows the serial output operation of the dual port memory to be performed in accurate synchrony with the serial clock signal SC and the scanning timing of the CTR [sic] and thereby provides stable displayed images even when an external high-resolution CTR [sic] with an extremely high dot rate for the displayed data is used.

As the foregoing description of the present embodiment shows, a semiconductor memory device such as a dual port memory that uses the present invention for image processing provides the following effects, namely:

- (1) When a dual port memory is in the read data transfer mode, by specifying - in synchrony with the activation control signal - the number of cycles of the serial clock signal between the activation and the start of the serial output operation on the read data and by counting down using the counter circuit provided in the timing control circuit TC, the serial output operation on the read data can be started with a timing that is synchronized in a stable manner with the serial clock signal.

- (2) Because of (1) above, a real time transfer of the read data can be performed in accurate synchrony with the serial clock signal SC and the scanning timing of the CTR [sic] and thereby provides stable displayed images even when an external high-resolution CTR [sic] with an extremely high dot rate for the displayed data is used.

The invention made by the inventor has been described hereinbefore in concrete terms using one embodiment of the invention, but the present invention is not restricted by the said embodiment. Needless to say, various modifications are possible without deviating from the gist of the invention. For example, the timing control circuit TC of Fig. 1 coordinates the timing by performing a count down operation with the counter circuit CRT. However, it is also acceptable to store the number of cycles ctrz of the serial clock signal SC supplied from the outside in a register and to count up the counter circuit CTR and to start the serial output operation when the output of the counter circuit CTR matches the number of cycles ctrz set in the register. It is also acceptable to decode the number of cycles ctrz, set a logical "1" in the corresponding bit of a separately provided shift register, shift the said shift register using the serial clock signal SC, and start the serial output operation when the said logical "1" has reached a prescribed position. With the present embodiment, the number of cycles ctrz is provided in synchrony with the falling level of the row address strobe signal \overline{RAS} , but it is also acceptable to do this in synchrony with the falling level of the column address strobe signal \overline{CAS} . Furthermore, it is acceptable for the dual port memory shown in Fig. 2 to comprise only one memory array or for the input/output circuit RIO for the random access port to be not provided with a logical operation circuit. In this manner, various modifications are possible in the block configuration, the combination of the control signals, etc. that are used.

Even though the description hereinbefore of the present invention was provided as applied to a dual port memory, the present invention is not restricted to use with dual port memories. For example,

the present invention can be used with various multi-port memories with a serial input/output function. At the least, the present invention can be used with semiconductor memory devices whose serial output operation is controlled by control signals and a clock signal that are provided from an external source.

Effects of the invention

The effects that are obtained from the representative example of the invention disclosed in this application are as follows. To explain, when a dual port memory is in the read data transfer mode, by specifying the number of cycles of the serial clock signal between activation and the start of the data transfer operation on the read data and by counting down using the counter circuit provided in the timing control circuit TC, the serial output operation on the read data can be started using a timing that is synchronized in a stable manner with the serial clock signal, and since a real time transfer of the read data can be performed in synchrony with the serial clock signal SC and the scanning timing of the CTR [sic], stable displayed images are obtained even when the dot rate of the displayed data is increased.

4. Brief description of the figures

Fig. 1 is a circuit diagram showing a part of one embodiment of a timing control circuit of a dual port memory that uses the present invention.

Fig. 2 is a block diagram showing one embodiment of a dual port memory that includes the timing control circuit shown in Fig. 1.

Fig. 3 is a timing chart of one embodiment of the read data transfer mode in a dual port memory shown in Fig. 2.

Fig. 4 is a timing chart for the read data transfer mode in a dual port memory which was developed by the inventor of the present application in concert with other individuals before the present invention.

TC:	Timing control
CTR:	Counter circuit
AG1 through AG2:	AND gate circuits
NAG1:	NAND gate circuit
N1 through N4:	Inverter circuits
M-ARY1:	Memory array
SA1:	Sense amplifier
CSW1:	Column switch
RCD:	Column address decoder for the random access port
SCD:	Column address decoder for the serial access port
RADB:	Row address buffer
AMX:	Address multiplexer
CADB:	Column address buffer
REFC:	Refresh address counter
DR1:	Data register
DSL1:	Data selector
PNT:	Pointer
RIO:	Input/output circuit for the random access port
FC:	Function control circuit
SIO:	Input/output circuit for the serial access port

Agent: Patent agent Masao Ogawa [Seal: Illegible]

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

$\frac{CAS}{CAS}$

$\frac{WE}{WE}$

$\frac{SOE}{SOE}$

$\frac{OE}{OE}$

$\frac{DT / OE}{DT / OE}$

$\frac{RAS}{RAS}$

RAS

$\frac{RAS}{RAS}$

CD1

$\frac{CD1}{CD1}$

$\frac{C1}{C1}$

$\frac{C8}{C8}$

PA 3108111 v1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.